

Inicio
Accesibilidad
Mapa web
Contacto
Directorio

ESTUDIANTES
PROFESORADO
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
VISITANTES Y EMPRESAS

NUESTRA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL

LISTADO DE CURSOS

ESTUDIOS Y ACCESO

INVESTIGACIÓN

Usted se ha identificado como RUBIO PEÑA LUIS (Salir)

Página Principal ► Mis cursos ► GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA ► 40210015_13_14_01 ► Tema 4 ► Evaluación continua:
Teoría de Electrónica 2 ► Vista previa

Navegación por el cuestionario

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

Terminar intento...

[Comenzar una nueva prueba](#)

Navegación

Página Principal

■ Área personal

Páginas del sitio

Mi perfil

Curso actual

40210015_13_14_0

Participantes

Informes


General


ELECTROTECNIA

Tema 2


Tema 3

Tema 4

 Modelos del
diodo de
unión

 Hojas de
características


 Vídeos
divulgativos

 Evaluación
continua:
Teoría de
Electrónica

 **Evaluación
continua:
Teoría de
Electrónica 2**

 Información

Resultados


 Evaluación
continua:
Problema
1 de

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar
pregunta

 Editar pregunta

¿Qué magnitudes relaciona la curva característica de un transistor de efecto de campo?

Seleccione una:


- ☐ a. Intensidad de corriente por la puerta y tensión drenador-fuente.
- ☐ b. Intensidad de corriente por la puerta y tensión puerta-fuente.
- ☐ c. Intensidad de corriente por el drenador y tensión drenador-fuente.
- ☐ d. Intensidad de corriente por el drenador y tensión puerta-fuente.

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar
pregunta

 Editar pregunta

Para que en un transistor MOSFET de acumulación de canal p se establezca una corriente eléctrica las tensiones deben ser

Seleccione una:


- ☐ a. $V_{GS} > 0$ y $V_{DS} > 0$.
- ☐ b. $V_{GS} < 0$ y $V_{DS} < 0$.
- ☐ c. $V_{GS} > 0$ y $V_{DS} < 0$.
- ☐ d. $V_{GS} < 0$ y $V_{DS} > 0$.

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar
pregunta

 Editar pregunta

Considere un transistor de silicio BJT npn donde $V_{BE} = 0.7$ V y $V_{CE} = 6$ V. Dicho transistor se encuentra en la región

Seleccione una:

- ☐ a. de saturación
- ☐ b. activa directa
- ☐ c. de corte

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar
pregunta

 Editar pregunta

Un transistor MOSFET de acumulación de canal n en la región óhmica

Seleccione una:

- ☐ a. aumenta su resistencia según aumenta V_{GS} .
- ☐ b. tiene una resistencia constante.
- ☐ c. disminuye su resistencia según aumenta V_{GS} .

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



 Marcar
pregunta



 Editar pregunta


La región de saturación de un transistor

Seleccione una:

- ☐ a. MOSFET y para un BJT, corresponde a la zona donde se comportan como una fuente de corriente.
- ☐ b. MOSFET corresponde a la zona donde éste se comporta como una fuente de corriente y para un BJT a la zona donde se comporta como fuente de tensión.
- ☐ c. BJT corresponde a la zona donde éste se comporta como una fuente de


 Electrónica
 Evaluación continua:
 Problema 2 de Electrónica

 Calificaciones evaluación continua parte de Electrónica
 Tema 5
 Tema 6
 Tema 7
 Tema 8
 Mis cursos

Ajustes



Administración del cuestionario
 ■ Editar ajustes
 ■ Anulaciones de grupo
 ■ Anulaciones de usuario
 Editar cuestionario

Vista previa
 ■ Filtros
 ■ Registros
 ■ Copia de seguridad
 Banco de preguntas

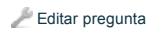
Administración del curso
 Cambiar rol a...
 Ajustes de mi perfil

Agregar un bloque
 Agregar...

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



corriente y para un MOSFET a la zona donde se comporta como fuente de tensión.

☐ d. MOSFET corresponde a la zona donde éste se comporta como una fuente de corriente y para un BJT a la zona anterior a la activa directa con valores de tensión entre colector y emisor de valor absoluto bajo.

¿En qué regiones de funcionamiento operan como fuentes de corriente los transistores bipolares y los de efecto de campo?

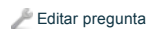
Seleccione una:

- ☐ a. Región activa directa y óhmica.
- ☐ b. Región de saturación y óhmica.
- ☐ c. Región de corte y de saturación.
- ☐ d. Región activa directa y de saturación.

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



En un transistor de silicio BJT npn polarizado en la región activa directa

Seleccione una:

- ☐ a. VCE es aproximadamente 3 V.
- ☐ b. VCE es aproximadamente -3 V.
- ☐ c. VCE es negativa con un valor que depende del circuito.
- ☐ d. VCE es positiva con un valor que depende del circuito.

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



¿En qué región de funcionamiento un transistor de efecto de campo se comporta como una fuente de corriente controlada por tensión?

Seleccione una:

- ☐ a. En la región de corte.
- ☐ b. En ninguna.
- ☐ c. En la región de saturación.
- ☐ d. En la región óhmica.

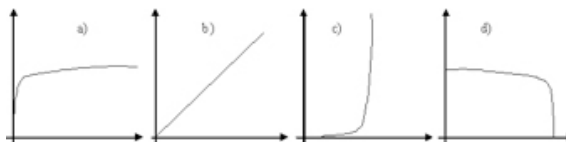
Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



¿Cuál de las siguientes curvas corresponde a la característica de salida de un transistor bipolar de unión?



Seleccione una:

- ☐ a. curva c
- ☐ b. curva a
- ☐ c. curva b
- ☐ d. curva d

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



En un transistor de efecto de campo en la región de corte, ¿qué intensidades de corriente son nulas?

Seleccione una:

- ☐ a. Sólo IG
- ☐ b. Todas
- ☐ c. Sólo IG e ID
- ☐ d. Sólo IG e IS

[Siguiente](#)

© Copyright Universidad de Cádiz			
Nuestra Universidad Estudios y acceso Investigación Internacional	Estudiantes Profesorado Administración y servicios Visitantes y compañías	 Universia	XHTML 1.0 CSS 2.1 WAI/AA Aviso legal 